二重管封入式温度勾配法を用いて作製した SnSe の結晶性におよぼす 冷却速度の影響

Influence of cooling rate on the crystallinity of SnSe fabricated by temperature gradient method

with double tubes seal

中部大工¹,名大工² ^O(B)寺社下 文也¹,田橋 正浩¹,高橋 誠¹

後藤 英雄¹, 土屋 雄司², 一野 祐亮², 吉田 隆²

Chubu Univ.¹, Nagoya Univ.², °Fumiya Jishage¹, Masahiro Tahashi¹, Makoto Takahashi¹,

Hideo Goto¹, Yuji Tsuchiya², Yusuke Ichino², Yutaka Yoshida²

E-mail: tahashi@isc.chubu.ac.jp

1. はじめに

近年、化石燃料の枯渇や温室効果ガスによる地球温暖化な どの環境問題が注目されている。そこで、熱電材料による熱 電変換発電から、工場、焼却炉、車等様々な場所で発生する 熱損失を有効なエネルギー源として回収することで、エネル ギー利用効率の向上、また温室効果ガスの排出がないことか ら環境問題解決にもつながるはずである。

様々な熱電材料の中でも SnSe は熱電材料の変換効率を表 す無次元性能指数 ZT が最大で、b 軸方向では 2.6 を、c 軸方 向では 2.3 と高い値を示すことが報告された^[1]。しかし、a 軸 方向では ZT が 0.8 と低い値を示すため、結晶方位が揃った SnSe の作製が必要となる。

本研究では前報⁽³⁾ に引き続き。単結晶基板上へ融液成長さ せた SnSe 結晶を対象とした。Fig. 1 に SnSe の状態図を示す ⁽²⁾。SnSe は冷却過程において 530 ℃ 付近で高温(β) 相から 低温(α) 相へ相変態する。前報では融点直上から相変態以 下の温度まで一定の冷却速度で冷却を行ったが、本報では凝 固時における冷却速度と相変態温度付近における冷却速度を 変化させ、これら冷却速度の違いが結晶性におよぼす影響に ついて調べた。

2. 実験方法

底面が正方形 (10mm×10mm) の形状を有する石英容器の底 に(100)MgO 基板を固定し、その上に Sn と Se の組成比が 1:1 とした SnSe 粉末を充填した。SnSe 粉末の蒸発を抑えるため、 少量の Se 粉末を重ね、石英容器の内側とほぼ同程度のサイズ を有する石英製のロッドを挿入した。Fig.2 に熱処理の温度プ ロファイルを示す。縦型管状電気炉内に上記試料を設置し、 1050 ℃まで加熱し試料を溶融させた。この温度で 60 分間保 持した後、融点直上から高温相(β 相)の領域にある 550℃まで 冷却速度 5, 10 ℃/hour で冷却させた。さらにここから低温相 (α 相) の領域にある 500 ℃ まで 5, 10 ℃/hour で冷却した。 また上記の高温相 550 ℃ および低温相 500 ℃ から室温まで 炉冷した試料も併せて作製した。このとき、試料の温度勾配 は約 3.5 ℃/mm であった。

作製した試料を厚さ 0.2 mm 程度に加工した後、結晶性の 評価には X線回折装置を,組成評価にはエネルギー分散型 X 線分光法を用いた。

3. 実験結果および考察

融点上から低温相領域の 500 ℃ まで一定の冷却速度 5, 10 ℃/hour で作製した。Fig. 3 に SnSe 結晶のへき開面に対す る 20 回折パターンを示す。主として SnSe(400)に注目した。 冷却速度 5 ℃/hour で作製した SnSe の半値幅が 0.23°であっ たのに対して、10 ℃/hour の半値幅は 0.18°と小さいことから、 冷却速度 10 ℃/hour で作製した SnSe の方が結晶性は高いこ とがわかる。





Fig. 3 XRD 2 θ scans of SnSe crystals fabricated by temperature gradient method at cooling rates of 5, 10°C/hour.

【謝辞】

本研究の一部は,科学研究費補助金(25289358,15H04252, 15K14301,15K14302,16K06277及び16H04512)および谷川熱 技術振興基金からの助成を受けて実施したものである。 文献

- [1] L. D. Zhao et al. : Nature, **508** (2014) 373.
- [2] H. Okamoto: Journal of Phase Equilibria, 19 (1998) 293.

[3] 辻岡他: 第77回応用物理学会秋季学術講演会, 14p-P22-10 (2016).